

### Features

- APD with 0.2 mm<sup>2</sup> active area
- Slow multiplication curve
- QE > 80% @ 750 nm-910 nm
- Fast rise time, low noise
- Optimum gain: 50-60

### Description

Circular active area APD chip with NIR enhanced sensitivity. Metal can type hermetic TO52 package with 905nm BP filter.

### Application

- Laser range finder
- High speed photometry
- High speed optical communications
- Medical equipment

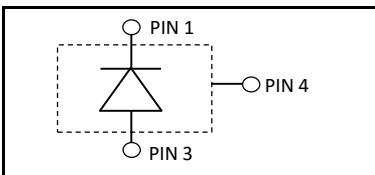
### RoHS

2011/65/EU

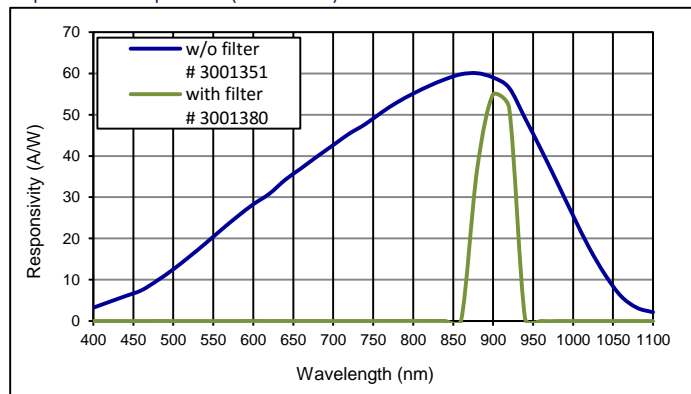
### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T <sub>STG</sub>	Storage temp	-55	125	°C
T <sub>OP</sub>	Operating temp	-40	100	°C
M <sub>max</sub>	Gain (I <sub>PO</sub> = 1 nA)	200		
I <sub>PEAK</sub>	Peak DC current		0.25	mA

### Schematic



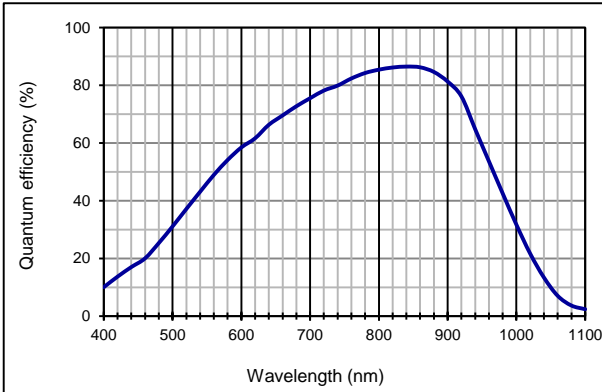
### Spectral response (M = 100)



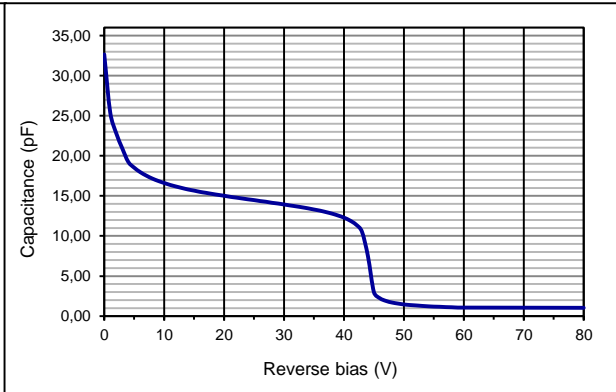
### Electro-optical characteristics @ 23 °C

Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	Active area		diameter 500			µm
	Active area		0.196			mm <sup>2</sup>
I <sub>D</sub>	Dark current	M = 100		0.8	2.0	nA
C	Capacitance	M = 100		1.2		pF
	Responsivity with filter	M = 100; λ = 905 nm	38	49		A/W
t <sub>R</sub>	Rise time	M = 100; λ = 905 nm; R <sub>L</sub> = 50 Ω		0.55		ns
	Cut-off frequency	-3dB		0.5		GHz
V <sub>BR</sub>	Breakdown voltage	I <sub>R</sub> = 2 µA	160		200	V
	Temperature coefficient	Change of V <sub>BR</sub> with temperature	1.25		1.55	V/K
	Excess noise factor	M = 100		2.5		
	Excess noise index	M = 100		0.2		

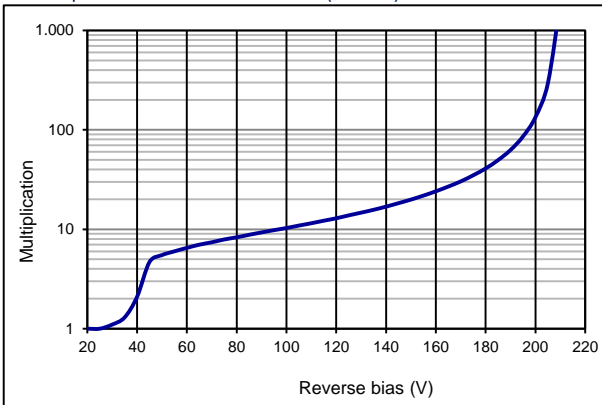
Quantum efficiency (23 °C)



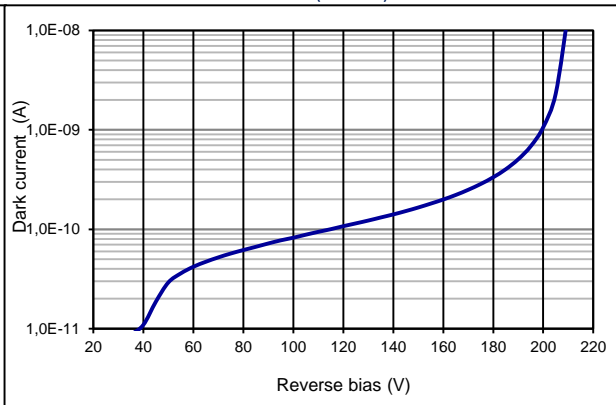
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)



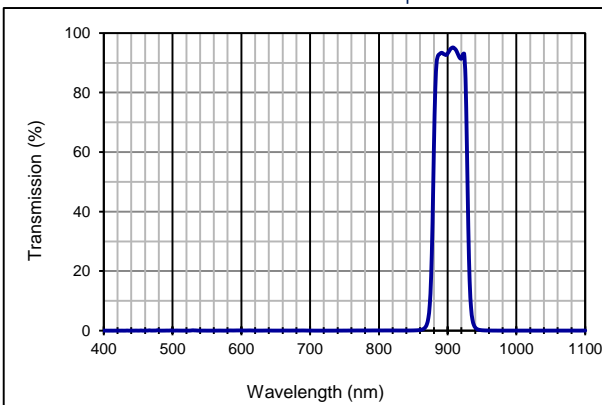
Multiplication as fct of bias (23 °C)



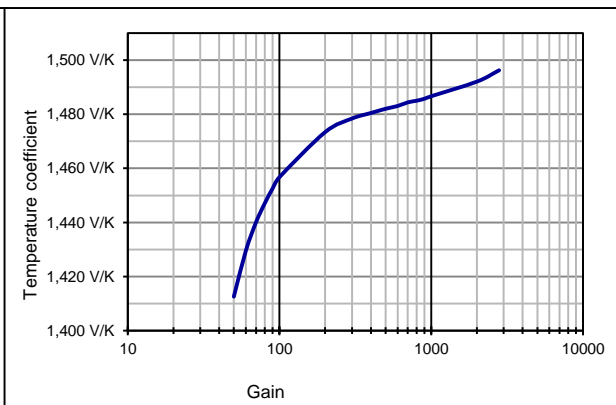
Dark current as fct of bias (23 °C)



Filter characteristics 905 nm band pass



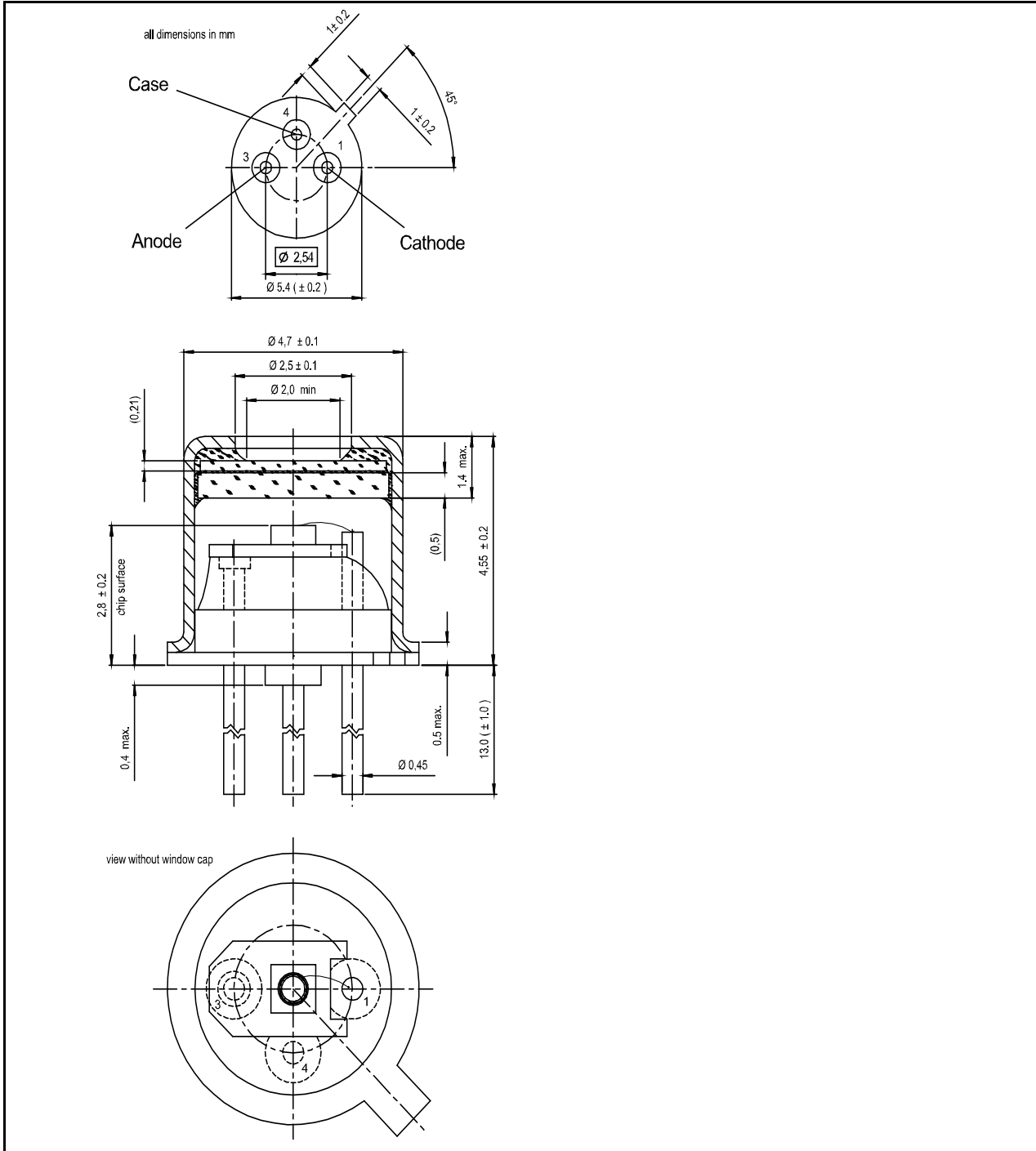
TC as fact of Gain



**Application hints:**

- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing"

Package: TO52S1F2



**Package dimension:**

Small quantities: Foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9